

СО АН: ЛЮДИ И ГОДЫ

# Сын Отечества

9 апреля 2010 года Анатолию Васильевичу Ржанову исполнилось бы 90 лет. Хотя и говорят, что время лечит, но до сих пор трудно и больно говорить о том, что с нами нет Анатолия Васильевича — прекрасного Человека, Солдата Великой Отечественной войны, академика.



Он вырос самыми тяжёлыми для нашей прекрасной Родины 20-30-е годы. Как сын военного, пережил много мест жительства, но школу посчастливилось закончить в Ленинграде. Отсюда же в 1941 году, досрочно защитив диплом в Ленинградском политехническом институте, добровольцем ушёл на фронт. Сражался в рядах морской пехоты на знаменитом Ораниенбаумском пятатке. В 1943 он уже командовал отрядом разведчиков морской пехоты и неоднократно совершал дерзкие вылазки в тыл врага. В одной из боевых операций был тяжело ранен. Госпитали, операции, больничные койки. И так несколько лет.

Как только позволило здоровье, Анатолий Васильевич поступает в аспирантуру знаменитого Физического института им. П.Н. Лебедева, которую блестяще заканчивает в 1948 году. Несмотря на очень заманчивые перспективы в развитии керамических пьезоэлектриков, которые он показал в своей диссертации, по поручению тогдашнего директора ФИАН (одновременно Президента АН СССР) С.И. Вавилова переключился на исследование полупроводников. Совместно с группой таких же энтузиастов нового направления в лаборатории академика Б.М. Вула были выращены первые монокристаллы германия и проведены первые исследования его свойств. Затем был изготовлен первый в нашей стране транзистор. (Как бы в подарок ко дню рождения в февральском номере «Вестника РАН» опубликована статья В.М. Березовской «ФИАН — создатель первого российского транзистора», где подробно излагается роль А.В. Ржанова в этом событии). С тех пор научные интересы А.В. Ржанова навсегда связаны с полупроводниками.

В 1962 году по приглашению академика М.А. Лаврентьева он с группой сотрудников переезжает в новосибирский Академгородок, где по постановлению Совета министров СССР организует Институт физики твёрдого тела и полупроводниковой электроники (после объединения в 1964 году с Институтом радиоэлектроники — Институт физики полупроводников). Надо отметить, что в это время Анатолий Васильевич, кроме работы в ФИАН, занимал пост Учёного секретаря Государственного Комитета СМ СССР по коор-

динации научных работ.

После переезда в Сибирское отделение за относительно короткое время был создан коллектив учёных и инженеров, способных выполнять глубокие фундаментальные и прикладные исследования. В числе таких разработок можно упомянуть энергонезависимые матричные элементы памяти, различные приборы и устройства СВЧ-электроники и фотоприёмные устройства от видимого до дальнего инфракрасного диапазона спектра излучения. Причём эти разработки использовались не только полупроводниковыми предприятиями Новосибирска, но и другими ведущими производителями полупроводниковых приборов по всей стране.

Анатолий Васильевич много сил отдавал воспитанию молодых кадров. Он руководил многочисленными аспирантами, организовал в НГУ кафедру физики полупроводников. Его лекции по физике поверхности полупроводников, прочитанные в НГУ и изданные затем в виде учебных пособий, его монографии до сих пор помогают молодёжи разбираться в этом сложном разделе физики полупроводников. В числе его учеников сейчас уже насчитывается один академик и четыре члена корреспондента, десятки докторов и кандидатов наук.

Плодотворную научную работу А.В. Ржанов успешно сочетал с научно-организационной деятельностью. Долгое время он являлся заместителем председателя Сибирского отделения АН СССР, зам. председателя Научного совета по физике и химии полупроводников, главным редактором журнала «Микроэлектроника», председателем комиссии по элементной базе Комитета по вычислительной технике АН СССР. В течение многих лет представлял нашу страну в Международном вакуумном союзе. За мужество и героизм, проявленные на фронте, он был награждён боевыми орденами и медалями. За заслуги в мирное время — орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции.

Он был очень добрым человеком, без оглядки кидался на защиту своих сотрудников и друзей, попавших в беду. Бескомпромиссно боролся с возникающими на сложном пути руководителя недобросовестностью, нечестностью и другими жизненными неприятностями, проявляя все качества отважного командира-разведчика, приобретённые им в боевых условиях на фронте.

Анатолий Васильевич любил жизнь во всех её проявлениях. На своём катере он объездил Обское водохранилище и спускался далеко вниз по Оби. Исходил с ружьём большую часть Новосибирской области. Азартно спорил не только на научные темы, но и по поводу проблем литературы, музыки, истории, живописи. И почти всегда одерживал верх в возникающих дискуссиях благодаря своей широчайшей эрудиции в самых разных областях человеческой деятельности. Его с полным основанием можно было назвать одним из немногих энциклопедически образованных людей нашего времени.

Он очень любил свою семью — жену, детей и особенно внуков, которым отдавал в последние годы своей жизни большую часть времени.

Хочется закончить это краткое воспоминание об Анатолии Васильевиче Ржанове словами поэта:

«Не говори с тоской — их нет, но с благодарностью: БЫЛИ!»

А.Л. Асеев, И.Г. Неизвестный

## Конкурс

**Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет.** Физический факультет объявляет выборы на замещение вакантных должностей: заведующего кафедрой физики полупроводников; заведующего кафедрой общей физики. Требования: ученая степень или ученое звание; квалифицированный специалист соответствующего профиля; научный или научно-педагогический стаж — не менее 5 лет. Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования объявления. Документы направлять по адресу: 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2. Справки по тел.: 330-09-55 (управление кадров).

**Факультет естественных наук Новосибирского государственного университета** объявляет конкурс на замещение ва-

кантных должностей: кафедра химии окружающей среды: заведующий кафедрой, профессор — 1, доцент — 2; кафедра катализа и адсорбции: доцент — 1, ассистент — 1; кафедра общей химии: профессор — 1, ассистент — 3; кафедра органической химии: доцент — 1; кафедра молекулярной биологии: старший преподаватель — 1, ассистент — 1; кафедра физической химии: ассистент — 1; кафедра аналитической химии: доцент — 1; кафедра цитологии и генетики: профессор — 1, старший преподаватель — 1; кафедра общей биологии и экологии: старший преподаватель — 4; кафедра информационной биологии: старший преподаватель — 2. Срок подачи документов для участия в конкурсе — не позднее одного месяца со дня опубликования объявления. Документы подавать по адресу: 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова 2, ФЕН НГУ; тел.: 339-41-88, 339-41-92.

# К 70-летию академика Б.М. Ковальчука

## Дорогой Борис Михайлович!

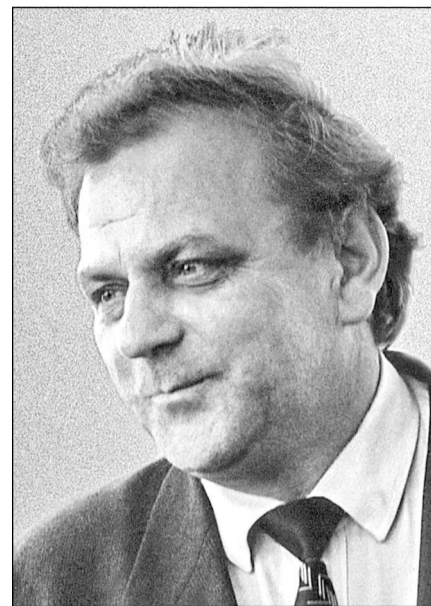
Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и Объединенный ученый совет по физико-техническим наукам СО РАН сердечно поздравляют Вас со славным юбилеем!

Весь мир знает Вас как одного из выдающихся ученых в области импульсной энергетики. Вами были заложены основы нового научного направления — физики и техники генерирования мощных электрических импульсов и созданы сверхмощные электрофизические установки национального и международного масштабов.

Мировая известность Института сильноточной электроники СО РАН во многом связана с Вашими работами, где под Вашим руководством созданы: первый отечественный ускоритель электронов, первые отечественные сверхмощные газовые лазеры, первый импульсный генератор с индуктивным накопителем энергии и плазменным прерывателем тока. При непосредственном Вашем участии и консультациях создаются мощные импульсные генераторы, в том числе мультитераваттный импульсный генератор ГИТ-12.

Сегодня Вы — один из ведущих российских физиков — совместно с сотрудниками Института совершенствуете и создаете новые источники питания для мощных импульсных твердотельных лазеров, предназначенных для использования в системе лазерного инерциального термоядерного синтеза. Вами разработана новая концепция построения сверхмощных импульсных генераторов на основе линейного трансформатора, позволявшая радикально увеличить удельный энергозапас генераторов и упростить их строительство.

Ваши научные заслуги отмечены Государственными премиями СССР и РФ, Международной премией им. Эрвина Маркса. За заслуги в развитии отечественной науки и воспитании научных кадров Вы награждены ор-



денами: Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Вы и сейчас продолжаете вести интенсивную и плодотворную работу. Ваш живой интерес к науке, громадный опыт, интуиция и целеустремленность в решении сложнейших научных задач служат примером и привлекают к Вам молодых исследователей.

Мы от всей души поздравляем Вас, дорогой Борис Михайлович, с юбилеем, искренне желаем Вам здоровья, творческого долголетия, продолжения активной трудовой деятельности на благо нашей Родины!

Председатель Сибирского отделения РАН академик А.Л. Асеев  
Главный ученый секретарь СО РАН чл.-корр. РАН Н.З. Ляхов  
Председатель ОУС по физико-техническим наукам СО РАН академик А.Н. Скринский

## Глубокоуважаемый Борис Михайлович!

Томский научный центр СО РАН сердечно поздравляет Вас со знаменательным юбилеем — 70-летием со дня рождения! Практически ко всему, сделанному Вами в науке и практике, применимо слово «первый». На основе разработанных Вами импульсных генераторов были созданы первый сильноточный ускоритель электронов, первые отечественные сверхмощные импульсные газовые лазеры, первый импульсный генератор с индуктивным накопителем энергии и плазменным прерывателем тока.

Ваш труд позволяет России быть мировым лидером в импульсной энергетике. Томские ученые гордятся тем, что идеи, которые рождаются в кабинете академика Ко-

вальчука, в томском Академгородке, с высочайшим вниманием воспринимаются во всех странах, где разработки в области современной энергетики являются приоритетными. Ваш авторитет в мировом научном сообществе настолько высок, что ни один из крупных проектов в мире по созданию импульсных генераторов не обходится без Вашего участия или консультаций.

Стремление к творчеству, присущее истинному ученому, целеустремленность и настойчивость в достижении поставленных целей являются Вашими жизненными принципами.

В день славного юбилея желаем Вам творческого долголетия, крепкого сибирского здоровья, благополучия, новых свершений и открытий!

Президиум ТНЦ СО РАН

## XVIII международный научный симпозиум этноархеологов

Симпозиум «Интеграция археологических и этнографических исследований», посвященный 80-летию со дня рождения Павла Ивановича Пучкова и 80-летию со дня рождения Альфреда Хасановича Халикова, будет проходить с 6 по 8 октября 2010 г. в г. Казани.

Основные направления работы симпозиума:

- этноархеологические исследования: теория, источники, методика;
- историографические аспекты взаимодействия археологии и этнографии;
- научные результаты конкретных работ в области интеграции археологии и этнографии;
- связи археологии и этнографии с гуманитарными и естественными науками.

В рамках симпозиума планируется проведение семинара «Проблемы изучения и реконструкции костюма традиционных культур».

Бюро оргкомитета XVIII международного научного симпозиум «Интеграция археологических и этнографических исследований»: председатели оргкомитета — д.и.н., профессор Николай Аркадьевич Томилев (Россия, Омск), д.и.н. Рафаиль Сибгатович Халиков (Россия, Казань); заместители председателя оргкомитета — к.соц.н., доцент Г.Ф. Габдрахманова (Россия, Казань), к.и.н., доцент С.Н. Корусенко (Россия, Омск);

ученые секретари оргкомитета — к.и.н., доцент М.Л. Бережнова (Россия, Омск), к.и.н., доцент А.Г. Ситдиков (Россия, Казань).

В состав оргкомитета симпозиума вошли ученые: д.и.н., профессор С.И. Ажигали (Казахстан, Алматы), академик А.П. Деревянко (Россия, Москва, Новосибирск), академик В.И. Молодин (Россия, Новосибирск), д.и.н., профессор Д.Г. Савинов (Россия, Санкт-Петербург), д.и.н., профессор Е.В. Смытнына (Украина, Одесса), д.и.н., профессор Ю.С. Худяков (Россия, Новосибирск), д.и.н., профессор Л.А. Чиндина (Россия, Томск), к.и.н. С.В. Сулова (Россия, Казань), к.и.н. А.А. Чижевский (Россия, Казань), к.и.н. Д.Ф. Файзулина (Россия, Казань) и др.

Для участия в работе симпозиума необходимо до 10 мая 2010 г. подать заявку с указанием темы выступления, сведений об авторе (фамилия, имя, отчество полностью, место работы, должность, ученая степень и звание, рабочий и домашний адреса, телефоны, e-mail) и до 15 июня прислать в оргкомитет материалы для публикации в сборнике.

Языки симпозиума — английский, русский.

Заявки и статьи в электронном варианте просим высылать в оргкомитет по адресу: [integracia2010@mail.ru](mailto:integracia2010@mail.ru) (основной адрес для связи).

В случае невозможности представить электронный вариант по электронной почте, просим выслать его на дискете или в бумажном варианте по адресу: 644077, Омск-77, ул. Андрианова 28, Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН, Светлане Николаевне Корусенко.

Телефоны для связи: (3812) 67-33-35, 67-05-15, fax: (3812) 22-46-08.